# ETHYLENE TRIMERIZATION CATALYST AND METHOD FOR TRIMERIZING FTHYLENE USING SAME

Publication number: JP2000202299
Publication date: 2000-07-25

Inventor: OGURI MOTOHIRO; MIMURA HIDEYUKI; OKADA

HISANORI

Applicant: TOSOH CORP

Classification:

- International: B01J31/22; C07B61/00; C07C2/32; C07C11/107;

C08F4/60; C08F4/6192; C08F110/02; C07B61/00; B01J31/16; C07B61/00; C07C2/00; C07C11/00; C08F4/00; C08F110/00; C07B61/00; (IPC1-7): C07B61/00; B01J31/22; C07C2/32; C07C111/107;

C08F4/60; C08F110/02

- European:

Application number: JP19990011493 19990120 Priority number(s): JP19990011493 19990120

Report a data error here

#### Abstract of JP2000202299

PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently produce 1-hexene from ethylene with high selectivity by preparing an ethylene trimerization catalyst from a chromium complex with a coordinated neutral multidentate ligand, a metal alkyl compound and a topotactic reduction product accompanied with electron transfer. SOLUTION: The ethylene trimerization catalyst for the production of 1- hexene useful as a comonomer of linear low density polyethylene from ethylene is prepared using at least a chromium complex with a coordinated neutral multidentate ligand, a metal alkyl compound and a topotactic reduction product accompanied with electron transfer. The topotactic reduction product has been subjected to salt treatment, acid treatment or other treatments). The chromium complex is represented by the formula ACribn A is a neutral multidentate ligand, (n) is an integer of 1-3 and B is H, halocon, amido, alkoxide or the likel.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

徽则配号

(51) Int.Cl.2

B01J 31/22

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

FΙ

B 0 1 J 31/22

(11)特許出願公開番号 特開2000-202299 (P2000-202299A)

テーマコード(参考)

Z 4G069

(43)公開日 平成12年7月25日(2000.7.25)

DO NO OLIDO		DULI	,,,	20	40000
CO7C 2/32		C07C	2/32		4H006
11/107		1	1/107		4H039
COSF 4/60			4/60		4 J O 2 8
110/02					43020
110/02			10/02		
	審査前求	未請求 請求	Aの数7 OI	. (全17頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特順平11-11493	(71)出職人	000003300		
			東ソー株式	0-24:	
(22)出城日	平成11年1月20日(1999, 1, 20)			區市開成町4560	最極
	17411 17720 2 (2000 2100)	(79) K\$HR-#	小栗 元宏	10 th	11/12
		(14)759178		terberet de a serie	
				市別名6丁目	7-8
		(72)発明者	三村 英之		
			三重県四日1	市市別名3丁目	5-1
		(72)発明者	岡田 久則		
			三重県四日1	<b>节市垂坂町366-</b>	- 1
					最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 エチレンの三量化触媒及びこれを用いたエチレンの三量化方法

(57)【要約】

【課題】 エチレンから効率よく、かつ高選択的に1-ヘキセンを製造する。

【解決手段】 中性の多座配位子が配位したクロム錯

体、アルキル金属化合物及び電子移動を伴うトポタクテ ィックな還元反応生成物の少なくとも3成分からなる触

媒を用いる。

#### 【特許譜束の範囲】

【請求項1】中性の多座配位子が配位したクロム錯体。 アルキル金属化合物及び電子移動を伴うトボタクティッ クな還元反応生成物の少なくとも3成分からなるエチレ ンの三量化伸媒。

【請求項2】電子移動を伴うトポタクティックな測元反 応生成物が、塩類処理、酸処理及び/又はルイス塩基処 理をしたものであることを特徴とする請求項1に記載の エチレンの三量化触媒。

【請求項3】中性の多座配位子が配位したクロム錯体 が、下記一般式(1) (1)

ACrB.

(式中、Aは中性の多座配位子である。nは1~3の整 数であり、Bは水素原子、炭素数1~10の炭化水素 基、カルボキシレート基もしくはジケトナート基、ハロ ゲン原子、アミド、イミド、アルコキシド、チオアルコ キシド、カルボニル、アレーン、アルケン、アルキン、 アミン、イミン、ニトリル、イソニトリル、ホスフィ ン、ホスフィンオキシド、ホスファイト、エーテル、ス ルホン、スルホキシド及びスルフィドからなる群より選 ばれる 1種以上を表す) で示される錯体であることを特 徴とする請求項1又は請求項2に記載のエチレンの三量 化触媒。

【請求項4】中性の多座配位子が三脚型構造を有する。 とを特徴とする請求項1乃至請求項3に記載のエチレン の三量化触媒。

【請求項5】中性の多座駅位子がfacialに配位し たクロム錯体を用いることを特徴とする請求項1円至請

求項4に記載のエチレンの三量化触媒。 【請求項6】アルキル金属化合物が、下記一般式(2) (2)

(式中、pは0<p≤3であり、qは0≤q<3であっ て、しかもp+qは1~3である。Mはリチウム、マグ ネシウム、亜鉛、ボロン又はアルミニウムを表し、Rは 炭素数1~10のアルキル基からなる群より選ばれる1 種以上を表し、Xは水素原子、アルコキシ基、アリール 基及びハロゲン原子からなる群より選ばれる1種以上を 表す) で示される化合物であることを特徴とする請求項 1 乃至請求項5 に記載のエチレンの三量化触媒.

【請求項7】請求項1乃至請求項6のいずれかに記載の エチレンの三量化触媒の存在下で、エチレンを三量化す ることを特徴とするエチレンの三量化方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

R. MX.

【発明の属する技術分野】本発明は、エチレンの三量化 触媒及びそれを用いたエチレンの三量化方法に関する。 さらに詳しくは、線状低密度ボリエチレン (T.L.D.P. E)の原料コモノマーとして有用な1~ヘキセンをエチ レンから効率よく、かつ高選択的に製造するエチレンの 三量化触媒及びそれを用いたエチレンの三量化方法に関 する。

[0002]

【従来の技術】エチレンを三量化1.71-ヘキャンを得 る方法において、特定の多座配位子が配位したクロム錯 体とアルキルアルミニウム化合物からなる触媒を用いる ことは公知である。例えば、特開平10-7712号公 報には、特定の窒素配位子が配位したクロムの塩素錯体 やアルキル錯体とアルミニウム化合物からなる触媒が、 特開平10-231317号公報には、環状ポリアミン 又はヒドロトリス (ピラゾリル) ボレートが配位したク ロム鉛体とアルキルアルミニウム化合物からなる触媒が 開示されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、特開平10-7712号公報に記載の方法は、触媒活性が低いという 問題があった。また、オリゴマー中の1-ヘキセン選択 性も低く、工業的な観点から十分なものではなかった。 また、特開平10-231317号公報に記載の方法も 触媒活性は低いものであった。さらに、選択性に関して も1-ヘキセンよりもポリエチレンの生成が多いばかり か、オリゴマー中の1-ヘキセン選択性も低いという欠 点があった。

【0004】本発明は上記の課題に鑑みてなされたもの であり、その目的は、LLDPEの原料コモノマーとし て有用な1-ヘキセンをエチレンから効率よく、かつ高 選択的に製造することができるエチレンの三量化齢度及 びそれを用いたエチレンの三量化方法を提供することで ある。

[0.005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課 題を解決するため鋭意検討を行った結果、中性の多座配 位子が配位したクロム錯体、アルキル金属化合物及び電 子移動を伴うトボタクティックな漫元反応生成物の少な くとも3成分からなるエチレンの三量化触媒を用いると 高い活性でエチレンの三量化反応が進行し、高選択的に 1-ヘキセンが生成することを見い出し、本発明を完成 するに至った。

【0006】即ち本発明は、中性の多座配位子が配位1、 たクロム錯体、アルキル金属化合物及び電子移動を伴う トボタクティックな選元反応生成物の少なくとも3成分 からなるエチレンの三量化触媒とこれを用いたエチレン の三量化方法に関する。

[0007]

【発明の実施の形態】次に、本発明についてさらに詳し く説明する。

【0008】本発明によれば、エチレンの三量化触媒を 構成する一成分として、電子移動を伴うトポタクティッ クな還元反応生成物が用いられる。

【0009】本発明における電子移動を伴うトポタクテ ィックな還元反応とは、R. Schollhornが、

Angew, Chem. Int. Ed. Engl. 1 9.983-1003(1980)で定義しているよう に、ホスト化合物が電子を得て滞元され、電荷のバラン スを取るためにゲストカチオンがホスト化合物中の空の

「式中、「〇」はホスト化合物であり、「は「〇】中の 空の格子サイトであり、e-は電子であり、xは還元量 であり、E\*は1価のゲストカチオンである1により例 示することができる。

> $(E^*_a + E^{2*}_{b/2} + E^{3*}_{c/3} + E^{4*}_{d/4} + E^{5*}_{c/5} + E^{6*}_{f/6} + E^{7*}_{g/7} + E^{8*}_{b/8} +$ E9+1/9+E10+1/10) (L2), [Q] k-

[式中、[Q]はホスト化合物であり、kは還元量であ る。またEはゲストカチオンであり、a+b+c+d+ e+f+g+h+i+i=kである。さらにL2はルイ ス塩基であり、hはルイス塩基量である] で表される化 合物を例示することができる。

【0011】ここで、[Q]としては、3次元構造を有 するホスト化合物、2次元模造を有するホスト化合物。 1次元構造を有するホスト化合物及び分子性関係である ホスト化合物を例示することができる。

【0012】3次元構造を有するホスト化合物として は、特に限定されるものではないが、例えば、八硫化六 モリブデン、ハセレン化六モリブデン、四硫化三モリブ デン、四硫化三チタン、ハセレン化六チタン、四硫化三 ニオブ、八硫化六パナジウム、八硫化五パナジウム、五 酸化二パナジウム、三酸化タングステン、二酸化チタ ン、二酸化バナジウム、二酸化クロム、二酸化マンガ ン、二酸化タングステン、二酸化ルテニウム、二酸化オ スミウム、二酸化イリジウムを例示することができる。 【0013】2次元構造を有するホスト化合物として は、特に限定されるものではないが、例えば、二硫化チ タン、二硫化ジルコニウム、二硫化ハフニウム、二硫化 バナジウム、二硫化ニオブ、二硫化タンタル、二硫化ク ロム、二硫化モリブデン、二硫化タングステン、二硫化 レニウム、二硫化白金、二硫化スズ、二硫化鉛、二セレ ン化チタン、ニセレン化ジルコニウム、ニセレン化ハフ ニウム、ニセレン化パナジウム、ニセレン化ニオブ、ニ セレン化タンタル、ニセレン化クロム、ニセレン化モリ ブデン、ニセレン化タングステン、ニセレン化レニウ ム、ニセレン化白金、ニセレン化スズ、ニセレン化鉛、 ニテルル化チタン、ニテルル化ジルコニウム、ニテルル 化ハフニウム、ニテルル化パナジウム、ニテルル化ニオ ブ、ニテルル化タンタル、ニテルル化クロム、ニテルル 化モリブデン、ニテルル化タングステン、ニテルル化レ ニウム、ニテルル化白金、ニテルル化スズ、ニテルル化 鉛、三硫化リンマグネシウム、三硫化リンカルシウム。 三硫化リンパナジウム、三硫化リンマンガン、三硫化リ ン鉄、三硫化リンコバルト、三硫化リンニッケル、三硫 化リンパラジウム、三硫化リン亜鉛、三硫化リンカドミ ウム、三硫化リン水銀、三硫化リンスズ、三セレン化リ

格子サイトに取り込まれる反応であり、しかも、反応前 後でホスト化合物の構造及び組成が何ら変化しない反応 である。この反応は、一般式(3)

#### $xE' + xe' + \Box[Q] \rightarrow (E'), [Q]^{x'}$

【0010】本発明における電子移動を伴うトポタクテ ィックな還元反応生成物は、上記の電子移動を伴うトボ タクティックな還元反応の生成物であり、一般式(4)

(4)

ンマグネシウム、三セレン化リンカルシウム、三セレン 化リンバナジウム、三セレン化リンマンガン、三セレン 化リン鉄、三セレン化リンコバルト、三セレン化リンニ ッケル、三セレン化リンパラジウム、三セレン化リン亜 鉛、三セレン化リンカドミウム、三セレン化リン水銀、 三セレン化リンスズ、四硫化リンクロム、タンタルスル フィドカーバイド、三酸化モリブデン、五十二酸化十八 モリブデン、五酸化バナジウムゲル、オキシ塩化鉄、オ キシ塩化チタン、オキシ塩化パナジウム、オキシ塩化ク ロム、オキシ塩化アルミニウム、オキシ塩化ビスマス、 α - 管化塩化ジルコニウム、β - 窒化塩化ジルコニウ ム、αー窒化臭化ジルコニウム、βー窒化臭化ジルコニ ウム、窒化ヨウ化ジルコニウム、窒化塩化チタン、窒化 臭化チタン、窒化ヨウ化チタン、グラファイト、ポリア センを例示することができる。

【0014】1次元構造を有するホスト化合物として は、特に限定されるものではないが、例えば、三硫化チ タン、三セレン化ニオブ、二硫化鉄カリウム、ポリアセ チレン、ポリアニリン、ポリピロール、ポリチオフェ ン、ボリ (pーフェニレン)、ポリ (トリフェニレ ン)、ポリアズレン、ポリフルオレン、ポリナフタレ ン、ポリアントラセン、ポリフラン、ポリカルバゾー ル、テトラチオフルバレン置機ポリスチレン、フェロセ ン置換ポリエチレン、カルバゾール置換ポリエチレン、 ポリオキシフェナジンを例示することができる。 【0015】分子性固体であるホスト化合物としては、 特に限定されるものではないが、例えば、テトラシアノ キノジメタン、テトラチオフルバレンを例示することが

できる。 【0016】さらに、[Q]としては、上記ホスト化合 物を複数混合して用いることもできる。

【0017】kは特に限定はないが、高い触媒活件でエ チレンの三量化を行うことを目的に、好ましくは0<k ≤3の範囲を用いることができる。さらに好ましくは0 < k ≤ 2の範囲を用いることができる。

【0018】以下においては、上記一般式(4)のE\* からE10+を簡便のため総称してEn+と表記する。ここ で、nは1~10の整数である。

【0019】 一般式 (4) のL2としては、E\*\*に配位

するルイス塩基を用いることができる。ルイス塩基は、 特に限定されるものではないが、例えば、水、アミン化 合物、窒素を含む複素環化合物、エチルエーテルもしく はローブチルエーテル等のエーテル類。ホルムアミド、 N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミ ドもしくはNーメチルアセトアミド等のアミド類、メチ ルアルコールもしくはエチルアルコール等のアルコール 類、1.2-ブタンジオール、1,3-ブタンジオー ル. 1. 4ーブタンジオールもしくは2. 3ープタンジ オール等のジオール類、グリセリン、ポリ (エチレング リコール)、ジグライム、1,2-ジメトキシエタン、 リン酸トリメチル、ヘキサメチルホスホルアミド、トリ - n - プチルリンオキサイド、1 . 4 - ジオキサン ア セトニトリル、テトラヒドロフラン、ジメチルスルフォ キシド又は炭酸プロピレンを例示することができるが、 これら2種以上を混合して用いることもできる。 【0020】hは0≤h≤10の範囲を用いることがで

きる。 【0021】上記一般式(4)のE・・としては、周期決 1~14歳の原子からなる事より選ばれる少なくとも1 種の原子を含むカオオンを用いることができる。高い検 業活性でエチレンの三量化を行うことを目的に、好まし くは、一般式(5)、(6)、(7)又は(8)

R<sup>1</sup>•R<sup>2</sup>NH\* (5)

[式中、R<sup>1</sup>2R<sup>2</sup>Nはアミン化合物であり、R<sup>1</sup>は各々独立して水素原子又は炭素数1~30の脂肪族炭化水素基であり、R<sup>2</sup>は水素原子、炭素数1~30の脂肪族炭化水素基又は炭素数1~50の芳香族炭化水素基である] T<sup>1</sup>H<sup>\*</sup> (6)

「式中、T<sup>1</sup>は窒素を含む複素環化合物である]

(R3) · (7)

[式中、(R3)・は炭素数1~50のカルボニウムカチオン又はトロビリウムカチオンである]

(8) ۱۰

【式中、Gは周順表1~14歳の原子からなる書より選ばれるかなくをも1種の原子、又はシフロベンタジエエールあが選札した金属原子であり、G・は1a値のカサオンである]で表されるカチオンが用いられる。これらのカチオンは、それぞれ単純で使用し得るのみならず、二種以上を用いることも可能である。

【00221 R)、IRNで表されるアミン配合物は、特に限定されるものではないが、例えば、メチルアミン、 エチルアミン、n - プロピルアミン、イソプロピルアミン、n - ブラルアミン、n - ブラルアミン、シープリルアミン、シープリルアミン、ジメチルアミン、ジスチルアミン、ジスチルアミン、ドリーn - ブチルアミン、トリアルアミン、トリアルアミン、1、5 - ジメチルスキン、ロープチルアミン、1、5 - ジメチルスキン・ローズチルアミン、1、5 - ジャチルスキン・ローズチルアミン、n - オクチル

アミン、t-オクチルアミン、ノニルアミン、デシルア ミン、ウンデシルアミン、ドデシルアミン、トリデシル アミン、テトラデシルアミン、ペンタデシルアミン、ヘ キサデシルアミン、ヘアタデシルアミン、オクタデシル アミン、ノナデシルアミン、シクロヘキシルアミン、シ クロヘプチルアミン、シクロヘキサンメチルアミン、2 メチルシクロヘキシルアミン、4-メチルシクロヘキ シルアミン、2、3-ジメチルシクロヘキシルアミン、 シクロドデシルアミン、2-(1-シクロヘキセニル) エチルアミン、ゲラニルアミン、 N-メチルヘキシルア ミン、ジヘキシルアミン、ビス (2-エチルヘキシル) アミン、ジオクチルアミン、ジデシルアミン、ジドデシ ルアミン、ジテトラデシルアミン、ジヘキサデシルアミ ン、ジオクタデシルアミン、N-メチルシクロヘキシル アミン、N-エチルシクロヘキシルアミン、N-イソプ ロビルシクロヘキシルアミン、N-t-ブチルシクロヘ キシルアミン、N-アリルシクロヘキシルアミン、N. N-ジメチルオクチルアミン、N. N-ジメチルウンデ シルアミン、N、N-ジメチルドデシルアミン、N、N ージメチルオクタデシルアミン、N. Nージオクタデシ ルメチルアミン、N, N-ジオレイルメチルアミン、ト リヘキシルアミン、トリイソオクチルアミン、トリオク チルアミン、トリイソデシルアミン、トリドデシルアミ ン、N, N-ジメチルシクロヘキシルアミン、N, N-ジエチルシクロヘキシルアミン等の脂肪族アミン類、ア ニリン、Nーメチルアニリン、N-エチルアニリン、N ーアリルアニリン、oートルイジン、mートルイジン、 p-トルイジン、N, N-ジメチルアニリン、N-メチ ルーoートルイジン、Nーメチルーmートルイジン、N ーメチルーpートルイジン、N-エチル-o-トルイジ ン、N-エチルーm-トルイジン、N-エチルーp-ト ルイジン、N-アリルーo-トルイジン、N-アリルー mートルイジン、Nーアリルーpートルイジン、Nープ ロピルーロートルイジン、N-プロピルーm-トルイジ ン、N-プロピルーp-トルイジン、2,3-ジメチル アニリン、2、4ージメチルアニリン、2、5ージメチ ルアニリン、2,6-ジメチルアニリン、3,4-ジメ チルアニリン、3、5 - ジメチルアニリン、2 - エチル アニリン、3-エチルアニリン、4-エチルアニリン、 N, N-ジエチルアニリン、2-イソプロピルアニリ ン、4-イソプロビルアニリン、2-t-ブチルアニリ ン、4-n-ブチルアニリン、4-s-ブチルアニリ ン、4-t-ブチルアニリン、2、6-ジエチルアニリ ン、2-イソプロビルー6-メチルアニリン、2-クロ ロアニリン、3-クロロアニリン、4-クロロアニリ ン、2-プロモアニリン、3-プロモアニリン、4-ブ ロモアニリン、ローアニシジン、mーアニシジン、ロー アニシジン、o-フェネチジン、m-フェネチジン、p ーフェネチジン、1-アミノナフタレン、2-アミノナ フタレン、1-アミノフルオレン、2-アミノフルオレ

ン、3-アミノフルオレン、4-アミノフルオレン、5 -アミノインデン、2-アミノビフェニル、4-アミノ ピフェニル、N. 2、3-トリメチルアニリン N. 2, 4-トリメチルアニリン、N, 2, 5-トリメチル アニリン、N, 2, 6-トリメチルアニリン、N, 3, 4-トリメチルアニリン、N、3、5-トリメチルアニ リン、N-メチルー2-エチルアニリン、N-メチルー 3-エチルアニリン、N-メチル-4-エチルアニリ ン、N-メチル-6-エチル-o-トルイジン、N-メ チルー2-イソプロビルアニリン N-メチル-4-イ ソプロピルアニリン、N-メチル-2-t-ブチルアニ リン. Nーメチルー4-n-ブチルアニリン、Nーメチ ル-4-s-ブチルアニリン、N-メチル-4-t、-ブチルアニリン、N-メチル-2、6-ジエチルアニリ ン、N-メチルー2-イソプロビルー6-メチルアニリ ン、N-メチル-p-アニシジン、N-エチル-2、3 -アニシジン、N、N-ジメチル-o-トルイジン。 N. N-ジメチル-m-トルイジン、N, N-ジメチル -p-トルイジン、N, N, 2, 3-テトラメチルアニ リン、N, N, 2, 4-テトラメチルアニリン、N, N, 2, 5-テトラメチルアニリン、N, N, 2, 6-テトラメチルアニリン、N、N、3、4-テトラメチル アニリン、N, N, 3, 5-テトラメチルアニリン、 N, N-ジメチル-2-エチルアニリン、N, N-ジメ チルー3-エチルアニリン、N、N-ジメチル-4-エ チルアニリン、N、N-ジメチル-6-エチル-o-ト ルイジン、N, N-ジメチル-2-イソプロピルアニリ ン. N. N-ジメチル-4-イソプロピルアニリン. N. N-ジメチル-2-t-ブチルアニリン、N. N-ジメチルー4ーnープチルアニリン、N、Nージメチル -4-s-ブチルアニリン、N, N-ジメチル-4-t ープチルアニリン、N, N-ジメチル-2、6-ジエチ ルアニリン、N. Nージメチルー2-イソプロビルー6 ーメチルアニリン、N、N-ジメチル-2-クロロアニ リン、N、Nージメチルー3ークロロアニリン、N、N -ジメチル-4-クロロアニリン、N, N-ジメチル-2-プロモアニリン、N, N-ジメチル-3-プロモア ニリン、N. Nージメチルー4ープロモアニリン、N. N-ジメチルーo-アニシジン、N, N-ジメチルーm -アニシジン、N, N-ジメチル-p-アニシジン、 N. N-ジメチルーo-フェネチジン、N. N-ジメチ ルーmーフェネチジン、N、Nージメチルーローフェネ チジン、N, N-ジメチル-1-アミノナフタレン、 N. N-ジメチル-2-アミノナフタレン、N. N-ジ メチル-1-アミノフルオレン、N、N-ジメチル-2 -アミノフルオレン、N, N-ジメチル-3-アミノフ ルオレン、N. N-ジメチル-4-アミノフルオレン、 N, N-ジメチル-5-アミノインデン、N, N-ジメ

チルー2ーアミノビフェニル、N. Nージメチルー4ー アミノビフェニル、N. Nージメチルーpートリメチル シリルアニリン等の芳香族アミン類を例示することがで きる。

【0023】TIで表される窒素を含む複素環化合物 は、特に限定されるものではないが、例えば、オキサゾ ール、イソオキサゾール、チアゾール、イソチアゾー ル、イミダゾール、ピラゾール、フラザン、ピリジン. ピリダジン、ピリミジン、ピラジン、ピロリン、ピロリ ジン、イミダゾリン、イミダゾリジン、ピラゾリン、ピ ラゾリジン、ピペリジン、ピペラジン、モルホリン、ピ コリン、コリジン、インドール、イソインドール、イン ダゾール、キノリン、イソキノリン、シンノリン、キナ ゾリン、キノキサリン、フタラジン、プリン、プテリジ ン、カルバゾール、フェナントリジン、アクリジン、フ ェナジン、フェナントロリン、インドリン、イソインド リン、2、5-ジメチルピロリジン、2-メチルピペリ ジン、3-メチルビペリジン、4-メチルピペリジン、 2.6-ジメチルピペリジン、3.3-ジメチルピペリ ジン、3、5ージメチルピペリジン、2-エチルピペリ ジン、2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン、1-メチルピロリジン、1-メチルピペリジン、1-エチル ピペリジン、1-ブチルピロリジン、1、2、2、6、 6-ペンタメチルピペリジンを例示することができる。 【0024】一般式(7)で表されるカチオンは、特に 限定されるものではないが、例えば、トリフェニルメチ ルカチオン、トロピリウムカチオンを例示することがで きる.

【0025】一根式(8)で表されるカナオンは、特に 際定されるものではないが、例えば、水素原子、リナウ ム原子、ナトリウム原子、のリウム原子、ルビシウム原 子、センウム原子、ベリリウム原子、アイネシウム原 子、カルシウム原子、ストロンチウム原子、バフニウム原子、 ホーステン原子、ジルコニウム原子、ハフニウム原子、 カル原子、施用子、独原子、平均30年子 アルミニウム テルスマンス原子のカナネンを伸ぶすることができる。ま た、シクロペンタジエール表が運換した金属原子は、特に に限定されるものではないが、例えば、フェロモニウム 、デカメチルフェロセニウム等を辨示することができる。 ボカメチルフェロセニウム等を辨示することができる。

【0026】本発明における電子移動を伴うトボタクティックな還元反応生成物の具体的な調製方法としては特に限定がないが、(a) ゲストカチオンになる原子の液体アンモニア落液にホスト化合物を没す方法 [式

(9)]、 [0027]

[#:1]

```
【0028】(b) ゲストカチオンになる原子とホスト 【0029】
化合物を100~1500℃で反応させる方法 [式(1 【化2】
                   (k/u) G + [G] \longrightarrow (G/u) G_{**} + k_G \cdot + [G]) \longrightarrow C_{*}^{ove}[G]_{F} (10)
【0030】(c) ゲストカチオンのハロゲン化物とホ 【0031】
スト化合物を100~1500℃で反応させる方法「式 【化3】
(11)1.
                (k/n) G^{**}[(X^{*})^{*}], i [Q] \longrightarrow ((k/n) G^{**} + ke^{-} + [Q]) \longrightarrow G^{**}_{not}[Q]^{k} (ii)
【0032】[式中、X*はハロゲン原子である]
                                             [0033]
(d) 還元試薬の非水溶媒溶液に、ホスト化合物を浸す 【化4】
方法[式(12)]、
                 (Q) \longrightarrow \{(h/h)G^{**} + he^{-} + \{Q\} + h(Solv^{*})\} \longrightarrow G^{**}_{out}(Solv^{*},iQ)^{*} 
(12)
【0034】 [式中、Red'はG**を含む還元試薬で [式(13)].
あり、Solv1は非水溶媒である]
                                             [0035]
(e) 還元試薬の水溶液に、ホスト化合物を浸す方法 【化5】
                 [G] \xrightarrow{} \{(g/u)G_{**} + FG_{*} + \{G\} + F(H^*O)\} \xrightarrow{} C_{*}^{*}(H^*O)^*\{G\}_{*}
(3)
【0036】[式中、Red2はG**を含む還元試薬で
                                             (14)],
ある1
                                              [0037]
(f)ホスト化合物をカソードとして、ゲストカチオン
                                             [化6]
を含む電解質溶液中で電気化学的に還元を行う方法「式
                    (k/z) E " + ke" + (Q) + b(Salv") ---
【0038】 [式中、Solv2は水又は非水溶媒であ
                                             て、ゲストカチオンになる原子を含むアノードを用いて
                                              電気化学的に還元を行う方法[式(15)]、
8]
(g) ホスト化合物をカソードとして、ゲストカチオン
                                             [0039]
を含むアノードを用いて電気化学的に還元を行う方法
                                             【化7】
[式(14)]、(h) ホスト化合物をカソードとし
                (k/a)G + [Q) \longrightarrow ((k/a)G^{**} + ke^{-} + [Q] + k(Se(r^{*})) \longrightarrow G^{*}_{we}(Se(r^{*}), [Q]). (15)
【0040】(i)アミン化合物とホスト化合物を10 【0041】
0~1500℃で反応させる方法 [式(16)]、 【化8】
                  (Q) \longrightarrow (k(T^*)H^* + ke^* + (Q) + kT^*) \longrightarrow ((T^*)H^*_{-}(T^*),(Q)^{\perp}
(16)
【0042】[式中、T2はアミン化合物である]
                                          [0043]
( j ) 窒素を含む複素環化合物とホスト化合物を100 【化9】
~1500℃で反応させる方法 [式(17)]、
                 (Q) \longrightarrow (k(T')H^{\bullet} + k_0 + (Q) + kT') \longrightarrow ((T')H^{\bullet}_{-}(T')L[Q]^{\bullet} (17)
【0044】を例示することができる。
                                            えば、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタ
【0045】方法(d)、(f)、(g) 及び(h)に ン、ノナン、デカン、シクロペンタンもしくはシクロへ おける非水溶媒は、特に限定されるものではないが、例 キサン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエンもし
```

【0046】方法(c)に関しては、ゲストカチオンの ハロゲン化物として、特に限定されるものではないが、 例えば、塩化リチウム、塩化ナトリウム、塩化カリウ ム、塩化ルビジウム、塩化セシウムを例示することがで きる。

【0047] 方法 (4) と関しては、混元法率として、 特に関連されるものではないが、例えば、nープチルリ チウム、ナフタレンリチウム、ナフタレンナトリウム、 ベンプフェノンリチウム、ベンプフェノンナトリウム、 ベンプフェノンリチウム、ベンプフェノンナトリウム、 001~1 0mol/lの濃度で、ホスト化合物1molに対して 0、001~10mol用いることができる。及心温度 は特に限別はないが、-100~100℃和いること ができ、反応物間に関しても特に限別はないが、1分~ 60日を用いることができる。

【0048】方法(e)に死して、災元就率は対に限ら されるものではないが、例えば、重二チオン粉ナトリウム、水素化ホウ素ナトリウム、硫化ナトリウムを例示す ることができ、0.001~10mol/10減度で、 ホスト化合物1molに対して0.001~10mol 用いることができる。反応進度は特に限定はないが、0 ~100℃を用いることができ、反応時間に関しても特 に限定はないが、1分~60日を用いることができる。 【0049】方法(f)に関して、電解質は特に限定さ れるものではないが、例えば、ダストカナスつの塩酸 鬼、リン酸塩、電酸塩、硝酸塩、メストカナスの塩酸 塩、リン酸塩、電酸塩、硝酸塩、シュウ酸塩、マロン 酸塩、コロビオン酸塩、シェウ酸塩、マロン 酸塩、コロビオンでは、テトラフルオフはつ飲塩、クエン酸塩、フロンカルコン・酸塩、クエン・酸塩、デトラフルオフはカイカ・バーの 塩及びヘキサフルオロリン・酸塩を例示することができ 0.001~10mol/1の濃度で用いることができ 0.001~10mol/1の濃度で用いることができ る。

【0050】方法(g)に関して、アノードは特に限定されるものではないが、例えば、グラファイトのアルカリ金属塩を例示することができる。

【0051】方法(h)に関して、アノードは特に限定

されるものではないが、例えば、リチウムを例示することができる。

【0052】方法(i)に関して、アミン化合物は特に 限定されるものではないが、例えば、アンモニア、前記 R¹<sub>2</sub>R²Nで表されるアミン化合物を例示することがで きる。

【0053】さらに、本発明における電子移動を伴うト ボタクティックな還元反応生成物は、必要に応じて塩類 処理、酸処理及び/又はルイス塩基処理して用いること もできる。

【0054】塩原処理に用いられる塩塩は、周期未1~ 14版の原子からなる群より選ばれる少なくとも一種の 原子を含む陽イオンと、ハロゲン原子、無機酸以は有機 酸の酸イオンからなる群より選ばれる少なくとも一種の 低イオンからなる群より選ばれる少なくとも一種の (5)、(6)、(7)又は(8)で表される陽イオン からなる群より選ばれる少なくとも一種の陽イオンと、 ファ素展子、熊原子、男原原子、ヨウ葉原子、リフ 酸、焼取、経酸、炭酸、塩塩紫酸、千酸、百酸、プロピ オン酸、シュウ酸、マロン酸、コハン酸、クエン酸、ア セトルアセトン、テトラフルオロボウ酸及びペキサフル オロリン酸の陰イオンからなる群より選ばれる少なくと も一種の際イオンからながまたる。

【0055】一般式(5)で表される陽イオンと、塩素 原子の陰イオンとからなる塩類としては、特に限定され るものではないが、例えば、前記R<sup>1</sup>2 R<sup>2</sup> Nで表される アミン化合物の塩酸塩を例示することができる。

【0056】一販式(6)で装される刷イオンと、塩素原子の陰イオンとからなる塩類としては、特に限定されるものではないが、例えば、前記でいて表される壁茶と合む検束限化合物の塩酸塩を例示することができる。 (0057】一股式(7)で表される陽イオンと、ハロゲン原子の際イオンとからなる塩類としては、特に限定されるのではないが、例えば、塩化トリフェニルメチル。塩かトロビリルを参照できたとかできる。

 ルミニウム、塩化スズ、フェロセニウム硫酸塩を例示す ることができる。

【0059】酸処理に用いられる酸としては、特に限定 されるものではないが、例えば、塩酸、リン酸、硫酸、 **硝酸、炭酸、過塩素酸、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、シ** ュウ酸、マロン酸、コハク酸、クエン酸を例示すること ができるが、2種以上混合して用いることもできる。 【0060】ルイス塩基処理に用いられるルイス塩基と しては、特に限定されるものではないが、例えば、水、 NH。、前記R1。R2Nで表されるアミン化合物。前記T 「で表される窒素を含む複素環化合物、エチルエーテル もしくはnープチルエーテル等のエーテル類、ホルムア ミド、N-メチルホルムアミド、N、N-ジメチルホル ムアミドもしくはN-メチルアセトアミド等のアミド 類、メチルアルコールもしくはエチルアルコール等のア ルコール類、1,2-プタンジオール、1,3-ブタン ジオール、1,4-ブタンジオールもしくは2,3-ブ タンジオール等のジオール類、グリセリン、ポリ (エチ レングリコール)、ジグライム、1、2-ジメトキシエ タン、リン酸トリメチル、ヘキサメチルホスホルアミ ド、トリーロープチルリンオキサイド、1、4-ジオキ サン、アセトニトリル、テトラヒドロフラン、ジメチル スルフォキシド又は炭酸プロピレンを例示することがで きるが、2種以上混合して用いることもできる。

[0061] 塩取処理、酸処理及び・欠以わイス塩基処理の方法としては、無類、酸及び・又はかイス塩基と流流、 又は短期、酸及び・又はかイス塩基と溶解させた溶液 に、方法(a)~(j)の還元反応で得られた生成物からなる形より選ばれる少なくとも1種の還元反応生成物 を没す方法を何末することができ

【0062】塩類処理と酸処理とルイス塩基処理を組み 合わせる場合においては、塩類処理を行った後、酸処理 を行う方法、塩類処理を行った後、ルイス塩基処理を行 う方法、酸処理を行った後、塩類処理を行う方法、酸処 理を行った後、ルイス塩基処理を行う方法、ルイス塩基 処理を行った後、塩類処理を行う方法、ルイス塩基処理 を行った後、酸処理を行う方法、塩類処理と酸処理を同 時に行う方法、塩類処理とルイス塩基処理を同時に行う 方法、酸処理とルイス塩基処理を同時に行う方法、塩類 処理を行った後、酸処理とルイス塩基処理を同時に行う 方法、酸処理を行った後、塩類処理とルイス塩基処理を 同時に行う方法、ルイス塩基処理を行った後、塩類処理 と酸処理を同時に行う方法、塩類処理と酸処理を同時に 行った後、ルイス塩基処理を行う方法、塩類処理とルイ ス塩基処理を同時に行った後、酸処理を行う方法、酸処 理とルイス塩基処理を同時に行った後、塩類処理を行う 方法、及び塩類処理と酸処理とルイス塩基処理を同時に 行う方法を用いることができる。

【0063】塩類、酸及びルイス塩基による処理条件は 特に限定はないが、塩類、酸及びルイス塩基は、0.0 01~10mo1/10端度で、還元反応生成物中のゲストカチオン1mo1に対して0.001~1000m o1、処理温度は−100~150℃、処理時間は1か -60日の条件を選択することが好ましい。また、これらの処理は、必要に応じて終り返し行ってもよい。

【0065】本発明において電子移動を伴うトボタクティックを置元反応生成物の使用景は、特に制限されるものではないが、後記のクロム道体1モルに対して0.0~1~1000kgであり、対ましくは0.1~1000kg、より軽ましくは1~500kgである。

【0066】本発明において、エチレンの三量化触媒を 構成する一成分として、中性の多座配位子が配位したク 口ム錦体が用いられる。中性の多座配位子が配位したク 口ム錦体は、下記一般式(1) ACrB。 (1)

(式中、Aは中性の多慮配位でである。 nは1~3の整 数であり、Bは水素原子、炭素数1~100敗化水満 基、力ルポキシレート基もしくはジナトナート薬、ハロ ゲン腐子、アミド、イミド、アルコキシド、チオアルコ キシド、カルボル、アレーン、アルウン、アルナン、アミン、イミン、ニトリル、イソニトリル、ホスファイト、エーテル、ス ルホン、スルホキシド、技びスルフィドからなる離より選 ばれる1 種以上を表す)で示される錯体が好適なものと して挙げるれる。

【0067】ここで、クロム錯体に配位させる中性の多 廃配位子として用いられるものは、特に限定されるもの ではないが、例えば、下記一般式(18) 【0068】

【化10】

【0069】(式中、a, b, cはそれぞれ独立した0 ~6の整数である。D!はそれぞれ独立して置換基を有 していてもよい2価の炭化水素差、1.7はそれぞれ独立 して高機差を有していてもよいへテロ元素基反は機業環 式化合物を表す。また、Gは炭化水素、ケイ素、窒素又 はリンを表す)で示される二脚型構造を有する多峰配位 子、下記一般式(19)

[0070]

【化11】

【0071】(式中、d, e, fはそれぞれ独立した1 ~6の整数である。Dはそれぞれ独立して置機基を有 していてもよいの偏の硬化水業、Dはそれぞの近 して置機基を有していてもよいへテロ元素基を表す)で 示される環境型構造を有する多座配位子及び下記一般式 (20)

[0072]

化121

【0073】(歌中、g. hはそれぞれ権立した○~6 の整数である。D\*1はそれぞれ独立して置換基を有して いてもよい2冊の炭化水素基、L\*1はそれぞれ独立して 置換基を有していてもよいテロ元素差又は推業環式化 合物を表す)で示されるブリッジ型構造を有する多度症 位子等が挙げられる。

【0074】上記一般式(18)、(19)及び(2 0)において、D1、D1及びD1法、特に限定されるも のではないが、配別は、アルキンン基、シロワルキレン基、フェニレン基、トリレン基、キシリレン基等が等 げられる。また、その置極重としては、例えば、メチル 基、エチル基等のアルキル基領、メキャン基、エトキン 基等のアルコキン基類等が挙げられる。

等のジアリールホスフィノ基、メチルフェニルホスフィ ノ基等のアルキルアリールホスフィノ基類が挙げられ る。

【0076】また、一般式(18)及び(20)において、上坂が上でたるのではないが、例えば、フリル素、ベンツフリル基、チエニル基、ベングチエニル基、とリジル基、インディリル基、チトラブリル基、チトラブリル基、ナングバリル基、オングバリル基、オングバリル基、オングバリル基、オングバリル基、オングバリル基、オングバリル基、オングルースを対象が入り、大型が、カースを対象が入れる。オース・アンール基等が挙げられる。これもの・プロデュスを対象が表現されています。

【0077】上記一般式(18)におけるGとしては、特に限定されるものではないが、例えば、メタン、エタン、アロバン、ブタン、トドロキシメタン、メチルシラン、フェニルシラン、アミン、ホスフィンオキシド、ホスフィンオキシドなが挙げられる。

【0078】上記一般式(18)で示される三川型構造 を有する多座配位子として通常用いられるものは、特に 限定されるものではないが、例えば、トリス (メトキシ メチル) メタン、1、1、1-トリス (メトキシメチ ル) エタン、1、1、1-トリス (メトキシメチル) プ ロバン、1,1,1-トリス (メトキシメチル) ブタ ン、1、1、1ートリス (エトキシメチル) エタン 1, 1, 1-トリス (プロポキシメチル) エタン、1. 1,1-トリス (プトキシメチル) エタン、1,1,1 ートリス (フェノキシメチル) エタン、トリフリルメタ ン、トリス(5ーメチルー2ーフリル)メタン トリス (5-エチルー2-フリル) メタン、トリス (5-ブチ ルー2-フリル)メタン、1、1、1-トリフリルエタ ン、トリフリルアミン、トリフリルホスフィン、トリフ リルホスフィンオキシド等の含酸素多座配位子類、1. 1,1-トリス(メチルチオメチル)エタン、1,1, 1ートリス (ブチルチオメチル) エタン、1、1、1。 トリス (フェニルチオメチル) エタン、トリス (チエニ ル)メタン等の含イオウ多座配位子類 1.1.1ート リス (ジメチルアミノメチル) エタン、1、1、1-ト リス (ジフェニルアミノメチル) エタン、トリス (ビラ ブリル)メタン、トリス(3,5-ジメチルー1ーピラ ゾリル) メタン、トリス (3、5 - ジイソプロビルー1 ーピラゾリル)メタン、1、1、1ートリス(3、5-ジメチルー1ーピラゾリル) エタン、1,1,1ートリ ス(3.5-ジメチル-1-ピラゾリル)プロバン、 1, 1, 1-トリス(3, 5-ジメチル-1-ピラゾリ ル) ブタン、トリス (2ーピリジル) メタン、トリス (6-メチル-2-ビリジル) メタン、トリス(2-ビ リジル) アミン、トリス (2-ピリジル) ホスフィン、 トリス (2ーピリジル) ホスフィンオキシド、トリス

(2-ピリジル)とドロキシィタン、トリス (1-イミ ゲアリル)メタン等の合策率多極能位す類、1、1、1 トリス (ジフェルホスフィノメチル)エタン、1、 1、1-トリス (ジスチルホスフィノメチル)エタン、 1、1、1-トリス (ジスチルホスフィノメチル)エタン、 1、1、1-トリス (ジスチルホスフィノメチル)エタン 学の合リン多級能位す損が挙行られる。

【0079】また、環状型構造を有する多座配位子とし ては、特に限定されるものではないが、例えば、1. 3,5-トリメチル-1,3,5-トリアザシクロヘキ サン、1、3、5-トリエチル-1、3、5-トリアザ シクロヘキサン、1,3,5-トリーi-プロピルー 1、3、5ートリアザシクロヘキサン 1、3、5ート リーセーブチルー1,3,5-トリアザシクロヘキサ ン、1、3、5ートリーnープチルー1、3、5ートリ アザシクロヘキサン、1,3,5-トリシクロヘキシル -1, 3, 5-トリアザシクロヘキサン、1, 3, 5-トリベンジルー1,3,5-トリアザシクロヘキサン、 3,5-トリフェニルー1,3,5-トリアザシク ロヘキサン、2,4,6-トリメチル-1,3,5-ト リアザシクロヘキサン、1、4、7-トリアザシクロノ ナン、1、4、7ートリメチルー1、4、7ートリアザ シクロノナン、1,4,7-トリエチル-1,4,7-トリアザシクロノナン、1、4、7-トリーi-プロビ ルー1、4、7ートリアザシクロノナン、1、4、7-トリーセープチルー1,4.7ートリアザシクロノナ ン、1、4、7-トリシクロヘキシル-1、4、7-ト リアザシクロノナン、1、4、7-トリフェニルー1、 4. 7ートリアザシクロノナン等の含窒素多座配位子 類、1、3、5-トリチアシクロヘキサン、1、4、7 ートリチアシクロノナン、1、4、7、10ーテトラチ アシクロドデカン、1,5,9,13-テトラチアヘキ サデカン等の含イオウ多座配位子類、1,3,5-トリ オキサシクロヘキサン、1,4,7-トリオキサシクロ ノナン、12-クラウン-4、15-クラウン-5、1 、8-クラウン-6等の含酸素多座配位子類が挙げられ

【0080】プリッジ型構造を有する多無配位子として は、特に限定されるものではないが、例えば、ビス(ジ メチルホスフィノエチル)メチルホスフィン、どス(ジ フェニルホスフィノエチル)フェニルホスフィン等の合 ソン多種配位子類、ジエチレントリアミン、ビス(ジエナルア ノエチル)エチルアミン、とス(フェニルアミ/エチ ル)アミン、α、α'、α' ー トリセリジン、2、6 ー ビス(2-フェニルー2-アザエテニル)ビリジン、ビス ズ [3 - (2-ビリジルエチルイミノ) - 2-ブタノン オキシム|等の意業多棒配位下類、ジエチレングリコ ールメチルエーテル、ビス(メトキシエチル)エーテル、ビス(ブトキシ エチル)エーデル、(世 - アトル、ビス(ブトキン エチル)エーデル、(世 - アトル、ビス(アトキン エチル)エーデル、(世 - アトル、ビス(アトキン エチル)エーデル、(世 - アトル・エチル)エーデル、ビス(アトキン エチル)エーデル、(世 - アトキシエチル)エーデル、ビス(アトキン エチル) エーテル等の含酸素多座配位子類が挙げられ

【0081】また、上記一般式(1)のBにおいて、炭 素数1~10の炭化水素基としては、特に限定されるも のではないが、例えば、メチル基、エチル基、プロビル 基。ブチル基。シクロヘキシル基。ベンジル基又はフェ ニル基等が挙げられる。炭素数1~10のカルボキシレ ート基としては、特に限定されるものではないが、例え ば、アセテート基、ナフテネート基又は2-エチルヘキ サノエート基等が挙げられる、炭素数1~10のジケト ナート基としては、特に限定されるものではないが、例 えば、アセチルアセトナート基等が挙げられる。ハロゲ ン原子としては、特に限定されるものではないが、例え ば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子等 が挙げられる。アミド基としては、特に限定されるもの ではないが、例えば、ジメチルアミド基、ジエチルアミ ド基、ジイソプロピルアミド基、ジオクチルアミド基、 ジデシルアミド基、ジドデシルアミド基、ビス (トリメ チルシリル) アミド基、ジフェニルアミド基 Nーメチ ルアニリド又はアニリド基等が挙げられる。イミド基と しては、特に限定されるものではないが、例えば、ベン ゾフェノンイミド等が挙げられる。アルコキシド基とし ては、特に限定されるものではないが、例えば、メトキ シド基、エトキシド基、プロポキシド基、プトキシド基 又はフェノキシド基等が挙げられる。チオアルコキシド 基としては、特に限定されるものではないが、例えば チオメトキシド基、チオエトキシド基、チオプロポキシ ド基、チオプトキシド基又はチオフェノキシド基等が挙 げられる。アレーンとしては、特に限定されるものでは ないが、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン、トリ メチルベンゼン、ヘキサメチルベンゼン又はナフタレン 等が挙げられる。アルケンとしては、特に限定されるも のではないが、例えば、エチレン、プロピレン、ブテ ン、ヘキセン又はデセン等が挙げられる。アルキンとし ては、特に限定されるものではないが、例えば、アセチ レン、フェニルアセチレン又はジフェニルアセチレン等 が挙げられる。アミンとしては、特に限定されるもので はないが、例えば、トリエチルアミン又はトリプチルア ミン等が挙げられる。イミンとしては、特に限定される ものではないが、例えば、ベンゾフェノンイミン又はメ チルエチルケトンイミン等が挙げられる。ニトリルとし ては、特に限定されるものではないが 例えば アセト ニトリル又はベンゾニトリル等が挙げられる。イソニト リルとしては、特に限定されるものではないが、例え ば、セーブチルイソニトリル又はフェニルイソニトリル 等が挙げられる。ホスフィンとしては、特に限定される ものではないが、例えば、トリフェニルホスフィン、ト リトリルホスフィン、トリシクロヘキシルホスフィン又 はトリブチルホスフィン等が挙げられる。ホスフィンオ キシドとしては、特に限定されるものではないが、例え

ば、トリプチルホスフィンオキシド又はトリフェニルは スフィンオキシド等が挙げられる。本スファイトとして は、特に限定されるものではないが、例えば、トリフェ ニルホスファイト、トリトリルホスファイト、トリプキ ルホスファイト、兄はトリエチルエスファイト等が挙げられる。 アーテルとしては、特に限定されるものではないが、例えば、ジエチルエーテル又はテトラトドロフラン がが挙げられる。スルホンとしては、特に限定される のではないが、例えば、ジメチルスルホン又はジプチル スルホン等が挙げられる。スルホキンドとでは、特に 限定されるものではないが、例えば、ジメチルスルホキ シド又はジブチルスルホキシド等が挙げられる。スルフ イドとしては、特に限定されるものではないが、例えば、ビメチルスルホキ シド又はジブチルスルホキシド等が挙げられる。スルフ イドとしては、対に限定されるものではないが、例えば、ビ

【0082】上記一般式(1)で示される中性の多序配 位子が配位したクロム錯体の具体的な例としては、特に 限定されるものではないが、例えば、トリス (メトキシ メチル) メタンクロムトリクロライド(III)、1、 1,1-トリス (メトキシメチル) エタンクロムトリカ ルポニル(0).1.1.1-トリス(メトキシメチ ル) エタンクロムトリクロライド(III)、1、1、 1-トリス (メトキシメチル) エタンートリス (ジイソ プロピルアミド) クロム ( I I I ) 、1、1、1-トリ ス (メトキシメチル) エタンートリス (ジメチルアミ ド) クロム (III)、1、1、1-トリス (メトキシ メチル) エタンートリス [ピス (トリメチルシリル) ア ミド] クロム (IIII), 1, 1, 1-トリス (メトキ シメチル) エタンクロムトリエトキシド (111)、 1, 1, 1-トリス (メトキシメチル) エタンクロムト リチオプトキシド(III)、1、1、1-トリス(エ トキシメチル) エタンクロムトリクロライド(II 1)、1、1、1-トリス (ブトキシメチル) エタンク ロムトリクロライド(III)、1、1、1・1ートリス (フェノキシメチル) エタンクロムトリクロライド (I II)、トリフリルメタンクロムトリカルボニル (0)、トリス(5-メチル-2-フリル)メタンクロ ムトリカルボニル(0)、トリス(5-ブチル-2-フ リル)メタンクロムトリカルボニル(0)、トリフリル アミンクロムトリカルボニル(0)、トリフリルホスフ ィンクロムトリカルボニル(0)、トリフリルホスフィ ンオキシドクロムトリカルボニル(0)、1、1、1-トリス (メチルチオメチル) エタンクロムトリカルボニ ル(0)、トリス(チエニル)メタンクロムトリカルボ ニル(0)、1、1、1-トリス(ジメチルアミノメチ ル) エタンクロムトリカルボニル(0)、トリス(ピラ ゾリル)メタンクロムトリカルボニル(0).トリス (3、5-ジメチルー1-ピラゾリル) メタンクロムト リカルボニル(0)、トリス(3,5~ジメチル-1-

ピラゾリル) メタンクロムトリクロライド(【 【 】 】).

トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタン-トリス (ジエチルアミド) クロム (III) . トリス (3、5~ジメチル-1-ピラゾリル) メタンートリス (ジイソプロピルアミド) クロム (III)、トリス (3,5-ジメチル-1-ビラゾリル)メタンートリス 「ビス(トリメチルシリル)アミドフクロム(II I) トリス(3、5ージメチルー1ーピラゾリル) x タンートリス (ベンゾフェノンイミド) クロム (II トリス(3,5ージメチルー1ーピラゾリル)メ タンクロムトリエトキシド(||||) トリス(3.5) ージメチルー1 - ピラゾリル) メタンクロムトリチオブ トキシド(III)、トリス(3、5-ジメチルー1-ピラゾリル) メタンートルエンクロム(0). トリス (3. 5ージメチルー1ーピラゾリル) メタンクロム (エチレン) ジカルボニル(0)、トリス(3,5-ジ メチルー1 - ピラゾリル) メタンクロム (フェニルアセ チレン) ジカルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチ ルー1-ピラゾリル) メタンクロム (ジメチルアニリ ン) ジカルボニル(0)、トリス(3、5ージメチルー 1-ピラゾリル) メタンクロム (ベンゾフェノンイミ ン) ジカルボニル(0)、トリス(3、5-ジメチルー 1-ピラゾリル) メタンクロム (アセトニトリル) ジカ ルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチルー1-ピラ **ゾリル)** メタンクロム (t-ブチルイソニトリル) ジカ ルポニル(0)、トリス(3、5ージメチルー1ーピラ ゾリル) メタンクロム (トリブチルホスフィン) ジカル ポニル(0)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾ リル) メタンクロム (トリプチルホスフィンオキシド) ジカルボニル(0)、トリス(3、5-ジメチル-1-ピラゾリル) メタンクロム (トリフェニルホスファイ ト) ジカルボニル(0)、トリス(3,5-ジメチルー 1-ピラゾリル) メタンクロム (テトラヒドロフラン) ジカルボニル(0)、トリス(3、5-ジメチル-1-ピラゾリル) メタンクロム (ジメチルスルホン) ジカル ボニル(0)、トリス(3、5ージメチルー1ーピラゾ リル) メタンクロム (ジメチルスルホキシド) ジカルボ ニル(0)、トリス(3,5-ジメチル-1-ピラゾリ ル) メタンクロム (ジブチルスルフィド) ジカルボニル (0)、トリス(3、5ージイソプロピルー1ーピラゾ リル) メタンクロムトリカルボニル(0)、1,1,1 ートリス(3,5ージメチルー1ーピラゾリル) エタン クロムトリカルボニル(0).1.1.1-トリス (3,5-ジメチル-1-ピラゾリル)プロバンクロム トリカルボニル(0)、1、1、1-トリス(3、5-ジメチルー1ーピラゾリル) ブタンクロムトリカルボニ ル(0)、トリス(2ーピリジル)メタンクロムトリカ ルボニル(0)、トリス(6~メチル-2-ピリジル) メタンクロムトリカルボニル(0)、トリス(2~ビリ ジル) アミンクロムトリカルボニル(0). トリス(2) ーピリジル) ホスフィンクロムトリカルボニル(0)、

トリス (2ーピリジル) ホスフィンオキシドクロムトリ カルボニル(0)、トリス(1-イミダゾリル)メタン クロムトリカルボニル(0)、1、1、1-トリス(ジ フェニルホスフィノメチル) エタンクロムトリカルボニ ル(0)、1,1,1-トリス(ジフェニルホスフィノメチル) エタンクロムトリクロライド( I I I ) . 1 . 1.1-トリス(ジメチルホスフィノメチル)エタンク ロムトリカルボニル(0)、1,1,1-トリス(ジェ チルホスフィノメチル) エタンクロムトリカルボニル (0)、1、1、1-トリス(ジエチルホスフィノメチ ル) エタンクロムトリクロライド (III)、1, 1, 1ートリス (ジエチルホスフィノメチル) エタンートリ ス (ジイソプロピルアミド) クロム ( I I I ) 等の三脚 型構造を有する多座配位子が配位したクロム結体が挙げ 【0083】また、1,3,5-トリエチル-1,3, 5-トリアザシクロヘキサンクロムトリカルボニル (0)、1、3、5ートリーiープロピルー1、3、5 トリアザシクロヘキサンクロムトリカルボニル (0)、1,3,5-トリーi-プロピルー1,3,5 トリアザシクロヘキサンクロムトリクロライド(TT I)、1、3、5-トリーi-プロピルー1、3、5-トリアザシクロヘキサンクロムジクロライド(II). ジクロロフェニルクロム-1,3,5-トリメチル-1,3,5-トリアザシクロヘキサンクロム(II ジクロロフェニルクロムー1、3、5ートリーi -プロピルー1、3、5-トリアザシクロヘキサンクロ ム(III)、1、3、5-トリーtープチル-1。 3,5-トリアザシクロヘキサンクロムトリカルボニル (0)、1,3,5-トリーt-ブチル-1,3,5-トリアザシクロヘキサンクロムトリクロライド(II 1). 1, 3, 5ートリーセーブチルー1, 3, 5ート リアザシクロヘキサンートリス (ジイソプロビルアミ ド) クロム (III)、1、3、5-トリシクロヘキシ ルー1,3,5-トリアザシクロヘキサンクロムトリカ ルボニル(0)、2,4,6-トリメチル-1,3,5 ートリアザシクロヘキサンクロムトリカルボニル (0)、1、4、7ートリメチルー1、4、7ートリア ザシクロノナンクロムトリクロライド(III). 1. 4,7-トリーt-ブチル-1,4,7-トリアザシク ロノナンクロムトリカルボニル(0)、1、3、5-ト リチアシクロヘキサンクロムトリカルボニル(0). 1.4.7-トリチアシクロノナンクロムトリカルボニ  $\nu$  (0), 1, 3, 5-トリオキサシクロヘキサンクロ ムトリカルボニル(0)、1,4,7-トリオキサシク ロノナンクロムトリカルボニル (0)等の環状型構造を 有する多座配位子が配位したクロム錯体が挙げられる。 【0084】さらに、ビス (ジメチルホスフィノエチ ル)メチルホスフィンクロムトリクロライド(II I)、ビス(ジフェニルホスフィノエチル)フェニルホ

活性の面から、一般式(1)の中性の多座配位子として は三脚型構造を有する多座配位子が好ましく用いられ る。また、Bとしてはカルボニル、炭素数1~10の炭 化水素基、ハロゲン原子、アミド及びチオアルコキシド が好ましく用いられる。より好ましくは三脚型構造を右 する多座配位子が配位したクロムのカルボニル錯体、ハ ロゲン錯体及びアミド錯体が用いられる。さらに好まし くは、トリス (3.5ージメチルー1ーピラゾリル)メ タンクロムトリカルボニル(0)、トリス(3、5-ジ メチルー1ーピラゾリル) メタンクロムトリクロライド (III)、トリス(3、5-ジメチル-1-ピラゾリ ル) メタンクロムトリス (ジイソプロピル) アミド (1 II)、1、1、1-トリス (メトキシメチル) エタン クロムトリカルボニル(0)等が用いられる。 【0086】本発明において、上記の中性の多座配位子 が配位したクロム錯体の合成法は、特に限定されるもの ではないが、例えば、中性の多座配位子とクロム化合物 とから公知の錯体形成法 [例えば、J. Amer. Ch em. Soc., 92, 5118 (1970) 及びAn gew. Chem. Int. Ed. Engl., 33. 1877(1994) 等] により容易に合成することが できる。この場合、使用できるクロム化合物としては、 特に限定されるものではないが、例えば、クロムヘキサ カルボニル(0)、ペンタカルボニル(トリフェニルホ スフィン) クロム(0)、テトラカルボニルビス(エチ レン) クロム(0)、トリカルボニル(ベンゼン) クロ ム(0)、トリカルボニル(トルエン)クロム(0) トリカルボニル(トリメチルベンゼン)クロム(0)、 トリカルボニル (ヘキサメチルベンゼン) クロム (0) トリカルボニル (ナフタレン) クロム (0) トリカルボニル (シクロヘプタトリエン) クロム (0)、トリカルボニルトリス (アセトニトリル) クロ ム(0)、トリカルボニルトリス(トリフェニルホスフ ァイト) クロム(0)、(エチレン) ジカルボニル(ト リメチルベンゼン) クロム(0)、シクロヘキシルイソ

ニトリルジカルボニル (トリメチルベンゼン) クロム (0)、トリプチルホスフィンジカルボニル(トリメチ ルベンゼン)クロム(0)、トリカルボニル(シクロペ ンタジエニル) クロム (1) ダイマー、ヒドリドトリカ ルボニル (シクロペンタジエニル) クロム (II) 等の クロムカルボニル化合物類、塩化クロム(III)、塩 化クロム(II)、臭化クロム(III)、臭化クロム ( I I ) 、ヨウ化クロム ( I I I ) 、ヨウ化クロム ( I フッ化クロム(III). フッ化クロム(I I)、トリス (テトラヒドロフラン) クロムクロライド ( I I I ) 、トリス (1, 4 -ジオキサン) クロムクロ ライド(III)、トリス(ジエチルエーテル)クロム クロライド(III)、トリス(ビリジン)クロムクロ ライド(III). トリス(アセトニトリル)クロムク ロライド(III)等のクロムハロゲン化物類、トリス (テトラヒドロフラン) クロムトリス (ジイソプロピル アミド) ( | | | | | ) 、トリス (テトラヒドロフラン) ク ロムトリス (ジエチルアミド) ( I I I ) 等のクロムア ミド類、クロム(IV) tープトキシド等のクロムアル コキシド類、クロム(III)アセチルアセトナート等 のクロムジケトナート類、クロム (III) 2-エチル ヘキサノエート、クロム ( I I I ) アセテート、クロム ( I I I ) ナフテネート等のクロムカルボン酸塩類が挙 ifsha.

【〇〇87】中性の多底配位子とクロム化合物を反応させ、クロム網体を形成させる際のプロム最高の表現点は存む開成されない。また、ここで用いられる溶雑とでは、特に開定されるものではないが、有機溶媒が好ましく用いられる。開送に、ベンタン、、ネサン、、プラン、、ラウン、デカン、シクロへキサン、デカリン等の間筋減度化水素取、ベンゼン、トルエン、キシン、ノメン、トリメチルへンゼンの方等が変化水素類、ジエチルエーテル、テトラとドロフラン等のスーテル紙、単化メチレン・クロンホルム、円磁化検索が呼げられる。また、上記路様は、それぞれ単数で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。

[0088]また。錦林帯坂太郎は、0℃から使用する 坂応藩保が海底はでか任意の海峡で行われ、葬せん 20~200℃である。反応時間は特に砂膜されず、通 常1分~48時間、野ましくは5分~24時間である。 なお、反応時のすべての操作は、変むた水分を測すで行 なうことが望ましい。また、原料及び溶媒は十分に乾燥 したおくことが得ましい。

[0089] 中性の多慮配位下が配位したクロム構体 は、通常温体として沈殿するので、ろ適により反応溶媒 から分解できる。さらに必要に応じて、上途溶媒を用い て洗浄を行い、次いで乾燥して、エチレンの三量化触媒 の構成成分の一つであるクロム循体が合成される。高、 洗験しない場合は、溶媒のよ、治療の水あんいは冷 却処理等により沈殿させることができる。

【0090】本邦明においては、中性の多慮配位子が追 位した少口ム場体を用いることが好ましい。多庭 配位がようなの人は他にしたクロ人場体を用いること とにより、ポリエナレンの歴史が抑えられる等の効果が 認められる。ここで、多庭配位子がすることに経位 した場体は、配位子が3つ配位したの 配位人団地を扱い の異性体の一つである「化予選書・有機金属化学ー基礎 と応用・、143頁(裳華房))、即ら、配位子が3つ 配位した6配位人間体型語をはておいて、3つの常位子は すべてシス位になるような配置で配位していることを意 味する。

【0091】本発明において使用されるアルキル金属化 合物は、特に限定されるものではないが、例えば、下記 一般式(2)

#### $R_{\bullet}MX_{a}$ (2)

(式中、PはOへP≤3であり、GはO≤の<3であっ て、しかもp+qは1〜3である。Mはリチウム、マグ ネシウム、聖前、ポロン又はブルミニウムを表し、Rは 炭素数1〜10のアルキル広からなる群より選ばれる1 種以上を表し、Xは木素原子、アルコキシ素、アリール 素及びハロゲン原子からなる群より選ばれる1種以上を 表す)で示される化合物が実達なものとして挙げられ 表す

【0092】上記一般式(2)において、炭素敷1~1 のアルキル添としては、特に限定されるものではなか が、例えば、メヤル素、エアルボ、アウビル素、アウビル素、アウエルス 水、原えば、メトキンル基、ストルスを分が維げられる。 アルコキン基としては、特に限定されるものではない が、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ブトキシあ又は フェノキシ基等が挙げられる。アリール基としては、等 に限定されるものではないが、例えば、フェニル基等 挙げられる。ハロゲン原子としては、特に限定されるも のではないが、例えば、フェルスを が終げられる。アロゲン原子としては、特に限定されるも のではないが、例えば、フェル素

が挙げられる。
(0093) なお、上記一般式 (2) において、MがA
1で、pと gがそれぞれ1、5のとき、A 1 R<sub>1。</sub> X<sub>1。</sub>
となる。このような化合物は、理論がは存在しない
が、通常、開用的にA 1 <sub>1</sub> R<sub>1</sub> X<sub>2</sub> かた。
(10994) 上記一根式 (2) で売されるため、ルールッチウム、アナルリチウム、ループ・ボルリチウム、メナルリチウム、メナルリチウム、アナルリチウム、アナルリチウム、アナルリチウム、アナルリチウム、アナルリケウム、アナルリナーな、ジェチルでダネシウム、エチルプロマグネシウム、エチルプロマグネシウム、エチルプロマグネシウム、エチルプロマグネシウム、アナルでア・トリエチルでリン、メートル電路、ジブチル電路、メデル・東京、ドリスチルボラン、トリスチルでデン、トリスチルでデン、トリスチルでデン、トリスチルでデン、トリスチルでデン、トリスチルでデン、トリスチルでデン、トリスチルでデン、トリスチルでデータ、トリスチルでデータ、トリスチルでデータ、トリューカーで、ア・ローカーで、ア・

キシルアルミニウム、トリーローオクチルアルミニウム、ドリシクロへキシルアルミニウム、ジメチルアチル アルミニウム、ジスチルアルミニウムとドリド、ジイソ ブチルアルミニウムとドリド、ジスチルアルミニウムエ トキシド、ジエチルアルミニウムスエルキシド、ジシク ロペキシルフェニルアルミニウム、エチルアルミニウム エトモンクロリド、ジエナルアルミニウムフロリド、ジ オトアルミニアウムブロミド、ジイソアチルアルミニウ ムクロリド、ジンクロペキシルアルミニウムクロリド、ジ メチルアルミニウムセンドアルミニウムクロリド、ジ スチルアルミニウムセンドフロリド、エチルアルミニウムセスキクロリド、ブチルアルミニウムセスキクロリド、エテルアルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウムジクロリド、エチルアルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウムビクロリド、エチルアルミニウムビクロリド、エチルアルミニウムビクロリド、エチルアルミニウムビクロリド、エチルアルミニウムビクロリド、エチルアルミニウムビクロリド、エチルアルミニウムビクロリド、エチルアルミニウムビクロリド、エチルアルミニウムビクロリド、エチルアルミニウムビクロドを添撃性を占む

[0095] これらのうち入手の容易さ及び活性の向から、アルキルアルミニウム化合物が對まして用いられ、 さらに対ましくはトリエチルアルミニウム又はトリイソ ブチルアルミニウムが用いられる。これらのアルキル金 風化合物は単独で使用い得るのみならず、二種以上を混 合して用いることも可能である。

【0096】アルキル金属化合物の使用量は、クロム錯体1モルに対して0.1~1000当量であり、好ましくは3~300当量、より好ましくは5~2000当量である。

[0097] 木県明の中性の多座配位すが電位したフロ 丸餅体、アルトルを風化合物なび電子静態を持ったファ クティックな運元反応生度物からなるエチレンの三量化 陰塚は、前記のフロム網体、アルキルを展化合物及び電 大学物数化すったオックティックな週末反応生成地を展料 に、溶線中で接触させることにより割製できる。接触方 法は特に制限されない。

【0098】この触媒を調製する際のクロム錯体の速度 は特に制限されないが、通常、溶媒11あたり0.00 1マイクロモル~100ミリモル、好ましくは0,01 マイクロモル~10ミリモルの濃度で使用される。これ より小さい触媒濃度では十分な活性が得られず、逆にこ れより大きい触媒濃度では、触媒活性が増加せず経済的 でない。また、ここで用いられる溶媒としては、例え ば、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタ ン、イソオクタン、ノナン、デカン、シクロペンタン、 シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、シクロオクタ ン、デカリン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエ ン、キシレン、エチルベンゼン、クメン、トリメチルペ ンゼン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン等の芳香族 炭化水素類及び塩化メチレン。クロロホルム。四塩化炭 素、ジクロロエタン等の塩素化炭化水素類が挙げられ る。また、反応生成物、即ち、1-ヘキセンを溶媒とし て用いることもできる。これらの溶媒は、それぞれ単独 で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いるこ とも可能である。ここで、エチレンの三量化反応時のク ロム錯体濃度をコントロールする目的で、必要に応じて

濃縮や希釈しても差し支えない。

【009】また、前型のプロム網体、アルキル金属化 合物及び電子移動を伴うトボタウティックな選元反応生 成物を登開を全意器の温度は-100~250℃、射ま しくは0~200℃である。接触時間は特に制限され 、1分~24世紀、20~12時間であ る。なお、接触時のすべての操作は、空気と水分を避け で行なうことが望ましい。また、原料及び溶解は十分に を繰上ておくことが望ましい。また、原料及び溶解は十分に を繰上ておくことが変ましい。

10101本売売のエキレンの三量化反応は、前記の フロム場体、アルキル金属化合物及び電子砂粉を伴うト ボクラティックと電元反応点成物からなる頻能とエチレンを接続させることにより行うことができる。無機が法 は特に調除されないが、例以に、正性仅定原料である エチレンの存在下に、フロム場体、アルキル金配化合物 及び電子砂砂を伴うトボクラ・ックを電元反延上成物 を接触させて、接触と同時に三量化反応を開始する方 法、又は27以場体、アルキル金配化合物 を推動させて、接触と同時に三量化反応を開始する方 法、又は27以場体、アルキル金配化合物 を作うトボクラティックを電元反逐上域や を持ち、ボクティックを電元反正金物を前もって接 踏させた。エチレンと接触させて三量化反応を行う方 法が保なれる。

【0101】具体的には、前者の場合は、(1)クロム 錯体、アルキル金属化合物、電子移動を伴うトポタクテ ィックな還元反応生成物及びエチレンをそれぞれ同時に 独立に反応系に導入する、(2)アルキル金属化合物を 含む溶液にクロム錯体、電子移動を伴うトポタクティッ クな還元反応生成物及びエチレンを導入する。(3)ク 口ム錯体、電子移動を伴うトポタクティックな還元反応 生成物を含む懸濁液にアルキル金属化合物及びエチレン を導入する。(4)アルキル金属化合物及び電子移動を 伴うトポタクティックな還元反応生成物を含む懸濁液に クロム錯体及びエチレンを導入する、(5)クロム錯体 を含む溶液にアルキル金属化合物、電子移動を伴うトポ タクティックな還元反応生成物及びエチレンを導入す る、という方法により三量化反応を行うことができる。 また、後者の場合は、(1)クロム錯体及び電子移動を 伴うトポタクティックな還元反応生成物を含む懸濁液に アルキル金属化合物を導入する。(2)アルキル金属化 合物及び電子移動を伴うトポタクティックな還元反応生 成物を含む懸濁液にクロム結体を導入する。(3)アル キル金属化合物を含む溶液にクロム錯体及び電子移動を 伴うトポタクティックな環元反応生成物を導入する

(4) クロム鉛体を含む溶液に電子移動を伴うトボタク ティックな選元反応生成物とアルキル金属化合物を導入 する、という方法により触媒を調製し、エチレンと接触 させて三葉化反応を行うことができる。なお、これらの 原料の混合機所は特に割限されない。

【0102】本発明においては、必要に応じて、中性の 多座配位子が配位したクロム錯体、アルキル金属化合物 及び電子移動を伴うトポタクティックな還元反応生成物 からなる 旌媒に光を照射し、エチレンの三量化反応を行ってもよい。光の照射により 旌媒活性が大幅に向上する 等の効果が認められる。

[0103] 本発明において使用される光は、特に限定されるものではないが、例えば、紫外光、可視光、赤外光が挙げられ、発光波長としては、0.2~2000 nmの光が野出しく、より好ましくは200~700 nmの光が用いられる。また、光の照皮は特に制膜されない。

[0104]光の光源としては太陽光区は人工楽器のいずれを用いてもよいが、太陽光は現底が小さく、天候に 影響され、彼声の使用ができないことから、人工光源が 望ましい、人工光源としては、特に現定されるものでは ないが、例えば、重水素ランプ、キセノシランプ、タングステンランプ、自然電像、ハロゲンランプ、 低圧 不服 ランプ、ホローカソードランプ、金属高気放電管、メラルハライドランプ、高圧トリカムランプ、タリウムランプ、オ銀ータリウムランプ、水銀一角ランプ、土瀬底 ア・大銀ラン、カ東・シェン・ア・大銀ランプ、高にア・サンア、高に大関ランプ、加高圧、水銀ランブ、カラシェランプで参呼すられる。

(0105)光の照射時期は、特に制限されるものではないが、前定のプロム静株、アルギルを腐化合物及が運 子野動を伴うよがタクチャックが選択反応を地域からなる を触媒に照射してもよいし、またエチレンの三量化反応 系に選携照射してもよい。なお、光の照射時間は特に制 限されない。

[0106]本架明におけるエチレンの三量化反反の温 酸は、一100~250℃であるが、 据ましくは0~2 00℃である。、反応圧力は、反応系がエチレン等側気で あれば特に制限されないが、 通常、 絶句圧での、01~ 3000kg/cm<sup>2</sup>であり、発生しくは0・1~30 0kg/cm<sup>2</sup>である。また、反応時間は速度や圧力に 左右され、一根に決めることはできないが、通常、 5秒 ~6時間である。また、エチレンは、 原記の圧力を保つ ように連絡的に供給してもよいし、反応開始時に前記圧 力で封入して反応をせてもよい、原材タであるエチレンには、反応に不活性なガス、例はは、 2端、 アルゴ ン、ヘリウム等が含まれていても何ら差し支えない。 な お、エチレンの三葉化反応がべての機相は、 空気と水 分を避けて行うことが望ましい、また、エチレンは十分 にを機しておくことが害としい、また、エチレンは十分

[0107] 木灰原は、旧分光、平回か点、透射式のいずれでも実施できる。エチレンの三星化反応終行後、反 応液に、例えば、水、アルコール、水酸化ナトリウム水 溶液等の場合失活剤を添加して反応を停止させる。失活 した施プロム機球は、シ島田の限火処理方法、例えば、水 以はアルカリ水溶液による他出等で除去した後、年成し た1 ーへキセンは、公知の地出法や流部法により反応後 より分離される。また、細化するポリエチレンは、反応 流出口で公知の違い分離法や一、へきとの恋報の発師 際の残渣として分離除去される。

#### [0108]

【実施例】以下に、本発明を実施例を用いてさらに詳細 に説明するが、これらの実施例は本発明の概要を示すも ので、本発明はこれらの実施例に限定されるものではな い。

#### 【0109】参考例1

シュレング管で、J. Amer. Chem. Soc. 29. 5118 (1970) に記載の方法で合成した三脚型階級を有するトリス (3, 5 - ジメチル・1 ーゼラ ゾリル) メタン 238mg、クロムへキサカルボニル 176mg、メジチルン40ml 及びトルエン10ml を混合し、無等剪照、下019間飛拝しながら地震流した。析出した結晶を方過し、トリス (3, 5 - ジメチル・1 モビラゾリル) メタンクロムトリカルボニ

(0) (以下、網体Aと終する)を得た。この網体Aの IR分析を行った結果、CO吸収に基づく2本のビーク が1896cm<sup>-1</sup>と1759cm<sup>-1</sup>に認められ、トリス (3,5-ジメチルー1-ビラブリル)メタンがクロム にfacialで配位していることを示した。

#### 【0110】参考例2

二硫化セリブデン7.0g(44mmo1)にn-ヘキ サン100mlを指加した後、n-ブチルリチウムの ヘキサン第6(1.54M)57ml(88mmo 1)を滴下した。この懸濁液を塞温で3日間指拌し、上 済液を除去した後、n-ヘキサンで洗浄した。その後、 返温、10-3Torrで乾燥して黒色固体を得た。得られた生 成物を元素分析した結果、組成は(Li<sup>\*</sup>)<sub>1.28</sub>[Mo 5.]1-10\* であった。

【0111】上記遺元反応生成物7.0gに25%アンモニア水130m1を添加した。この懸濁液を−30℃で30分間撹拌し、上澄液を除去した後、水で洗浄し

[0112] ジメチルアニリン塩敷塩7、1 g (45 m mol) き500 m 1 の水に溶解し、この水溶液に上部ルイス塩基処理生成物7、0 g を添加した、この磐霜液を室温で2 4 時間頻詳し、上済液を除止した後、水及びエグノールで洗浄した。その後、豪温 10<sup>24</sup> Torrで2 4 叫筒酸投、 黒色固修(10万・配合物・1 を元素分析した結果、構成は [P h (Me) 2, N H 1] 6,12 [Mo S<sub>2</sub>] 6.12 であった。

#### 【0113】実施例1

シュレンク管に、化合物-1を0.20g、0.154 mol/1のトリイソブチルアルミニウム/シクロへキ サン裕液2.1ml及び乾燥したトルエン40mlを入 れ、混合撹拌し、懸濁液を得た(以下、懸濁液Cと称す る)

【0114】温度計及び機样装置を備えた内容精150

m 1のガラス製剤社反応容器に、参考例1で合成した結体Aを6、9mg、0・15 4moi / 1のトリイソブトルアトミンカングラロハキサン溶溶2・1mlと乾燥したトルエン4 0mlを大れ、混合銀性した。ウシオ電気製麺店圧水提ランブ(500W)を用い、外部から光を30分間腕射した後、上部場別液でを混合した。【0115】反応容器を80次に加速し、展肝速度を1400 rpmに調整後、反反容器はエメトンを選入して、エチレンの三量化反応を開始した。反応容器中の絶対圧力を5kg/cmbとなるようにエチトレンガスを吹が圧力がある。 前に対している場合では、100mmの

【0116】 反応容器を室温まで冷却し、次いで似圧した。 反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガス クロマトグラフィーにより分析した。また、反応液に含 まれる関体分をう紙を用いてろ削し、これを風蛇後、減 圧下で乾燥(1 Torr 100℃)とて その食事を 測定した。さらに、この乾燥商体を電気炉で700°Cで 焼成して、その陰熱残りを測定し、乾燥商体から熱熱残 分を減じた重量をボリマー重量とした。結果を表1に示 す。

#### 【0117】実施例2

化合物-1を0.40g用いたこと以外、実施例1と同様にして反応を行なった。結果を表1に示す。 【0118】比較例1

化合物-1を用いなかったこと以外、実施例1と同様に して反応を行なった。結果を表1に示す。

【0119】比較例2

錯体Aの代わりに(1,3,5-トリメチルベンゼン) クロムトリカルボニル(0)(以下、錯体Bと称する) を4.1mg用いたこと以外、実施例1と同様にして反 応を行なった。結果を表1に示す。触媒活性は低く、ま たポリエチレンの副生が抑乱した。

【0120】 【表1】

		実施例1	実施例2	E-00-94 1	体験例2
放祥					15 101 4 2
Cr朝体		排作A	銀体A	競体A	総体B
	µmo l	16.0	16.0	16.0	16.0
アルキル全属	化合物	i-Bu-Al	i - Bu A I	I-BusAI	I-BuAL
	amo I	640	640	240	640
電子移動を伴うトボタクティ		化合物-1	化合物-1	1	化合物
ックな環元反応生成物 mg		200	400	_	200
溶媒		トルエン	トルエン	トルエン	トルエン
反応条件				1111	177
反応温度	t	80	8.0	8.0	8.0
反応圧力	kg/cm*	5	5	5	5
反影時間	分	30	8.0	30	30
結果					
触媒活性 g-1	イセン/g-Cr-瞬	2960	3 4 5 0	445	467
好体	wt%	93.8	92.5	99.0	
图体 (PE)		6. 2	7. 5	1. 0	47.6
被体中の	wt%	0. Z	1	1.0	52.4
生成物分布		2. 2	1.6	1	1
221001033 H	C 6	94. 7	95. 7	77. 9	7. 3
	C B	0. 4	0. 4	2. 3	69.9
	C10	1. 6	1. 3	5. 6	6. 2
	C12+	1. 1	1. 0	9. 8	
C 6 \$5/5	wt%	98. 2	98. 2	96. 2	10.6
			P & P (D) (C) # (L) (C)	90. 2	99.0

E) C4;7° 5>. C6;45>, C8;355>. C10;7° 5>. C12+;1° 9° 4>QL02; C588=(1-x30>/4x40>)x100

### [0121]

【発明の効果】本発明によれば、中性の多座配位子が配位したクロム錯体、アルキル金属化合物及び電子移動を 伴うトボタクティックな還元反応生成物の少なくとも3 成分からなるエチレンの三量化触媒を用いることによ り、エチレンから効率よく、かつ高選択的に1-ヘキセ ンを製造することができる。

#### フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7	識別記号	F I		テーマコード (参考)
// C07B 61/00	300	C O 7 B 61/00	300	

F ターム(参考) 4G069 AA06 BA21A BA21B BA27A BA27B BC04A BC10A BC16A

BC16B BC58A BC58B BD03A CB47

4H006 AA02 AC21 BA02 BA05 BA09 BA14 BA31 BA32 BA36 BA47

BA81 BA85 BA95 4H039 CA19 CF10

4J028 AA01A AA02A AB00A AB01A AC01A AC22A AC32A AC42A

AC44A AC45A BAOOA BAO1B

BBOOA BBOOR BROTH BCOTH

BCO6B BCO9B BC18B CAO7A

CA11A CA24A CA47A CA51A

CA58A